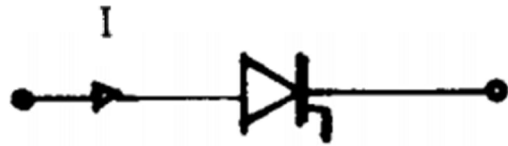
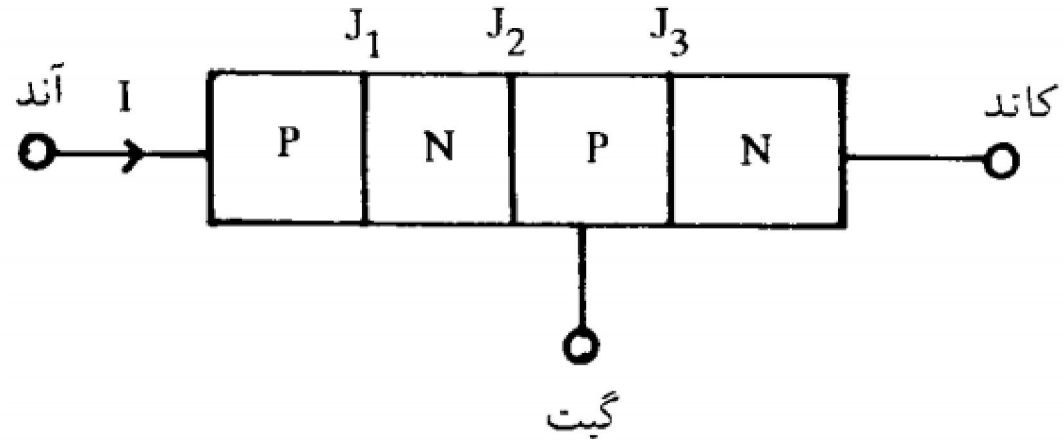
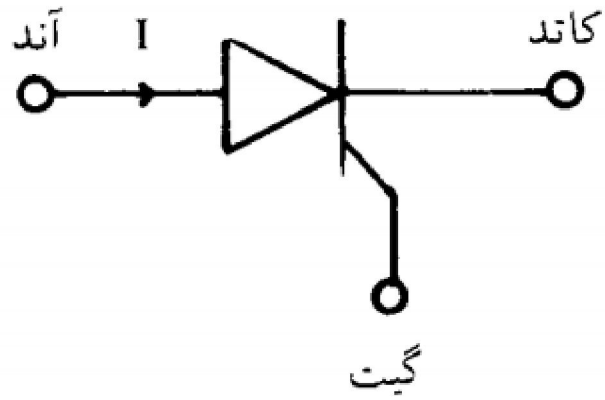


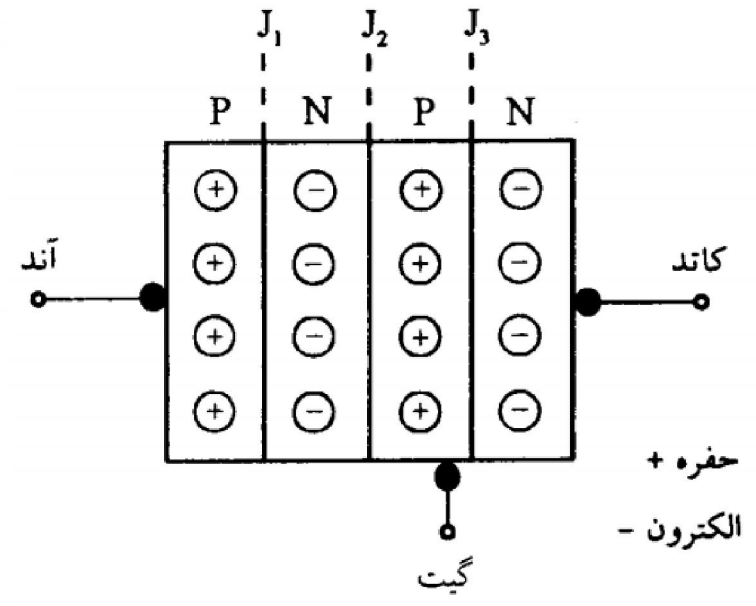
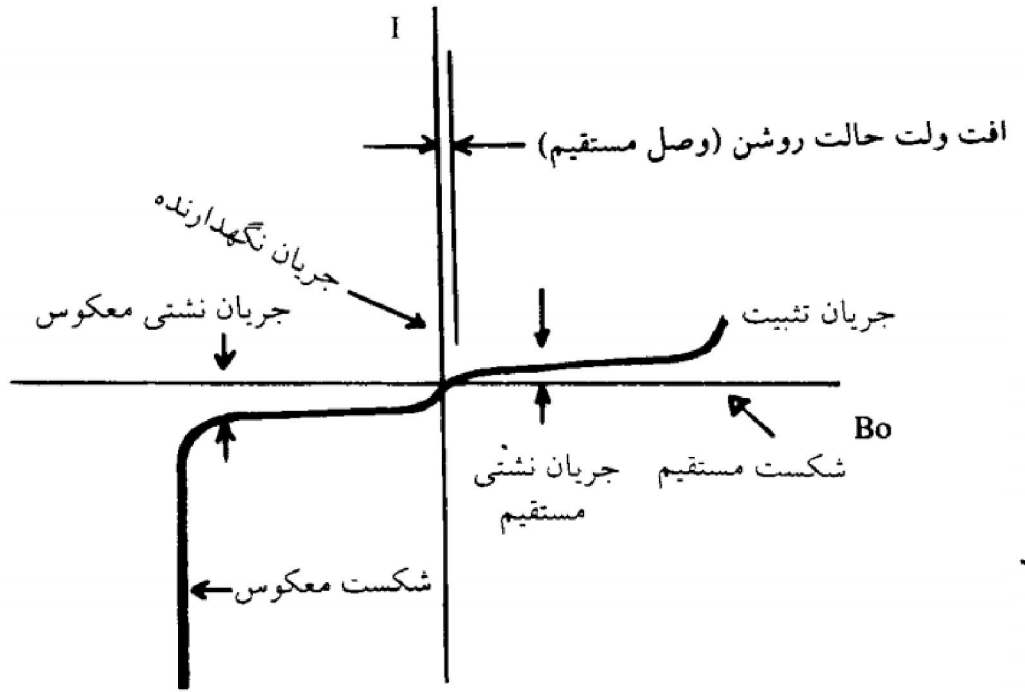
# وسایل نیمه هادی الکترونیک قدرت: تریستور یا SCR

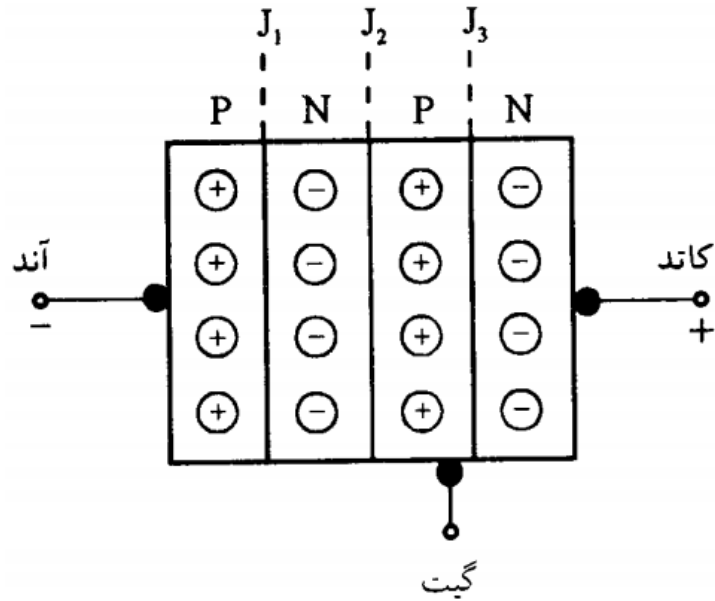
Solid-state Controlled Rectifier

ساختار و شکل مداری:



# مشخصه تریستور در غیاب سیگنال گیت



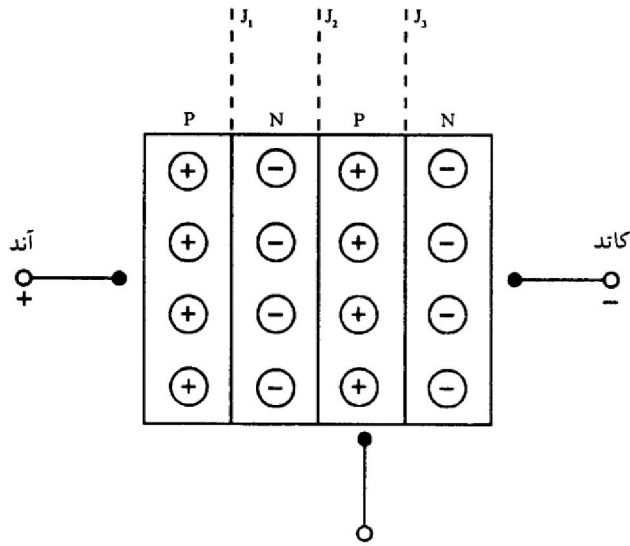


پیوند  $J_1$  که خالی از حاملهای بار پشده است، بایاس معکوس گردیده و مانع عبور جریان می شود. پیوند  $J_2$  که از حاملهای بار پر شده است، بایاس مستقیم گردیده و می تواند باعث عبور جریان شود. پیوند  $J_3$  همانند پیوند  $J_1$  است و مانع عبور جریان می گردد.

بنابراین در بایاس معکوس، تا قبل از رسیدن به نقطه شکست، دو پیوند  $J_1$  و  $J_3$  سدکننده و مانع عبور جریان هستند و فقط جریان نشتی معکوس<sup>۱</sup> کوچکی از تریستور عبور می کند. در این حالت گفته می شود که وسیله در حالت مسدود معکوس<sup>۲</sup> قرار دارد.

۱- Reverse leakage current

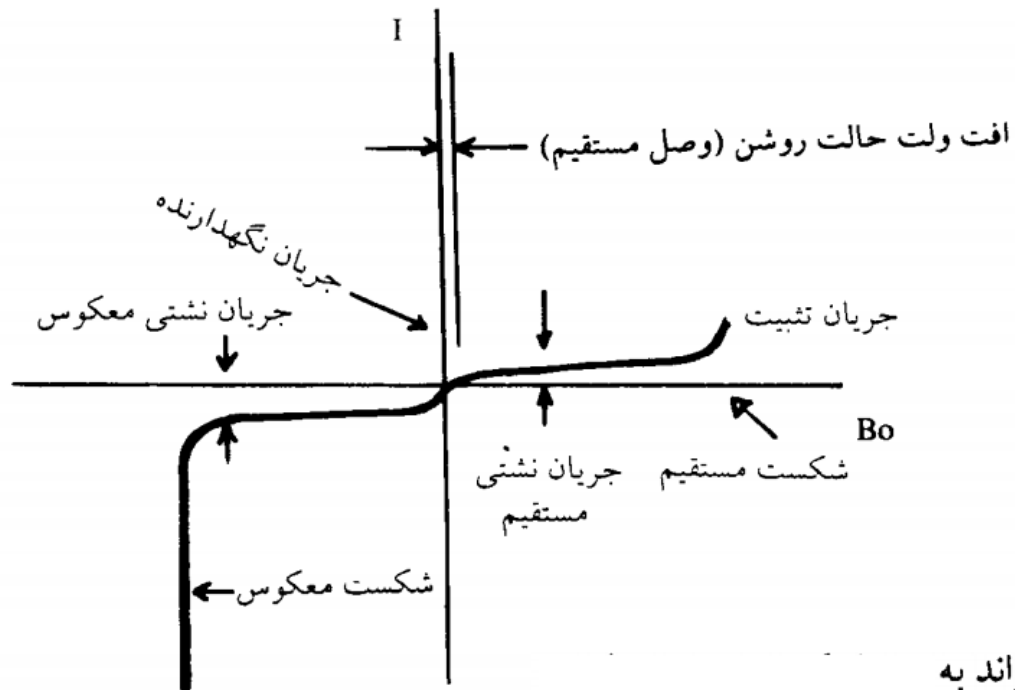
۲- Reverse blocking state



پیوند  $J_1$  که از حاملهای بار پر شده است، بایاس مستقیم گردیده و هادی جریان است.  
 پیوند  $J_2$  که از حاملهای بار خالی شده است، بایاس معکوس شده و مانع عبور جریان است.  
 پیوند  $J_3$  همانند پیوند  $J_1$  از حاملهای بار پر شده است و عبور جریان را آزاد می‌کند.  
 بنابراین در بایاس مستقیم، پیوند  $J_2$  سدکننده است و از تریستور فقط جریان نشتی مستقیم<sup>۳</sup> کوچکی عبور می‌کند. در این حالت، وسیله در حالت مسدود مستقیم<sup>۴</sup> قرار دارد.

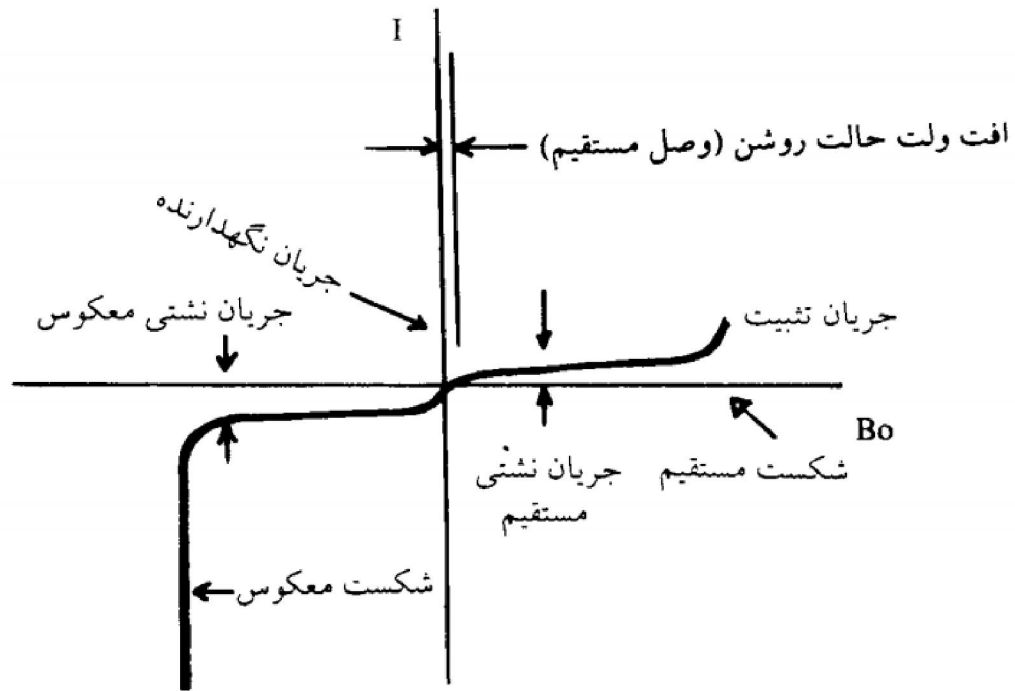
۳- Forward leakage current

۴- Forward blocking state



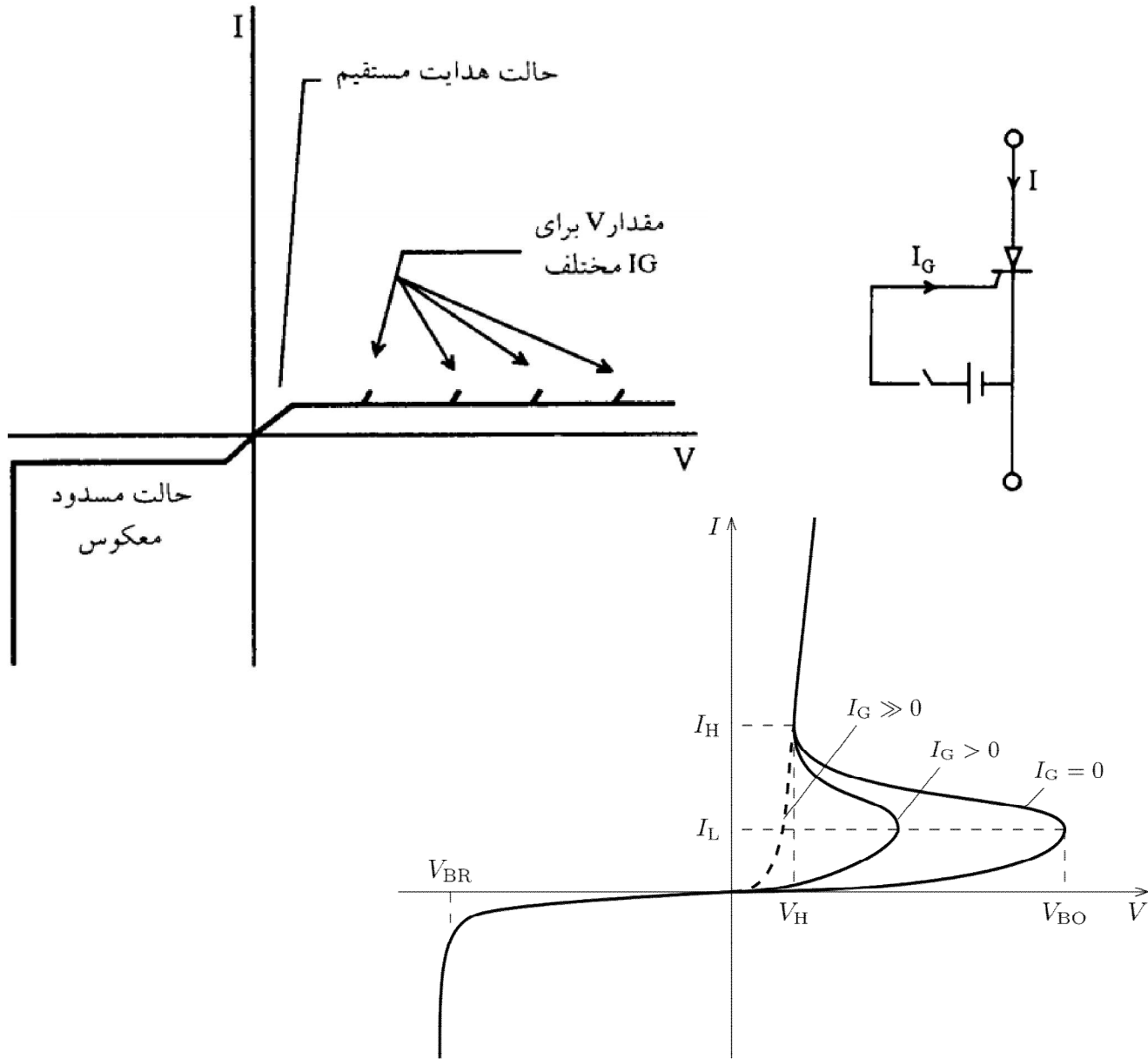
بنابراین برای اینکه تریستور بتواند به

حالت روشن (وصل) برسد و در آن باقی بماند، بایستی مطابق شکل جریان آند به مقدار جریان تثبیت کننده برسد و از مقدار جریان نگهدارنده کمتر نگردد. این مقدار جریان برای نگاه داشتن میزان موردنیاز عبور حاملهای بار لازم است. در غیراین صورت به محض اینکه ولتاژ آند-کاتد کاهش یابد وسیله به حالت مسدود باز می‌گردد. بطور نمونه جریان تثبیت دو برابر جریان نگهدارنده است اما مقدار هر دو کم بوده و از یک درصد جریان نامی هم کمتر است.

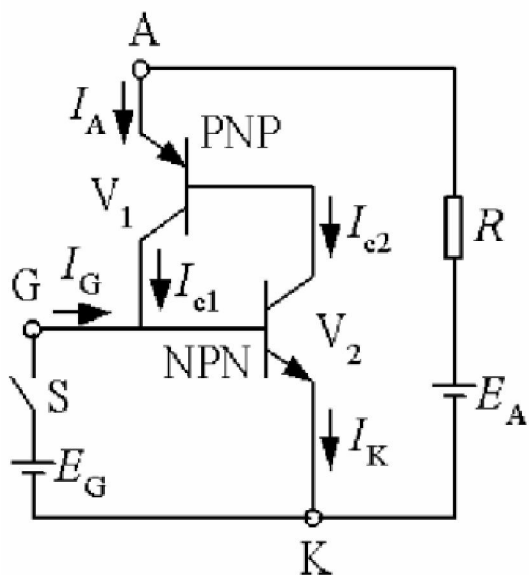
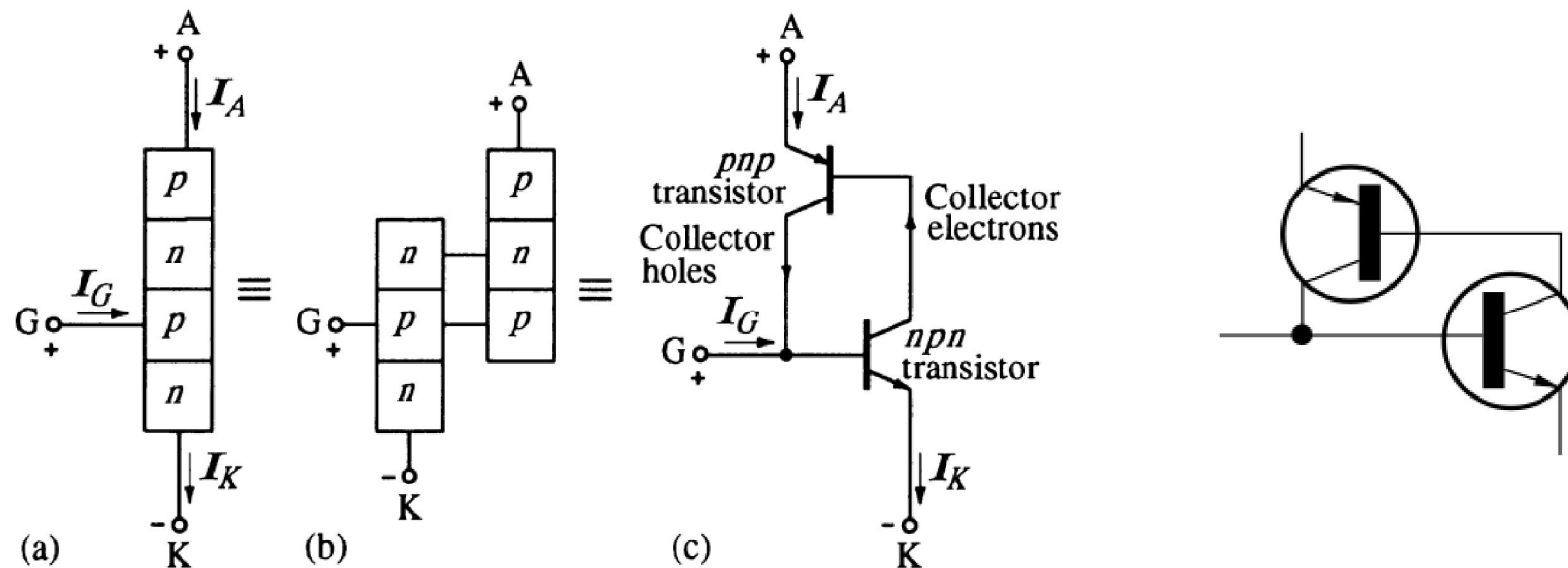


هنگامی که تریستور بایاس معکوس می شود رفتار وسیله مانند دو دیود است که بطور سری بهم متصل اند و ولتاژ معکوس به دو سر آن اعمال می شود.

می توان نتیجه گرفت که تریستور یک عنصر دو حالتی است، یکی حالت روشن (وصل) و دیگری حالت خاموش (قطع). عبور از حالت قطع به حالت وصل که با افزایش ولتاژ بایاس مستقیم تا رسیدن به ولتاژ شکست (عبور) مستقیم  $V_{BO}$  تحقق می یابد، روشن کردن نامیده می شود. عکس این حالت که خاموش کردن نام دارد با کاهش جریان آند به میزان کمتر از جریان نگهدارنده  $I_{H}$  عملی می شود.





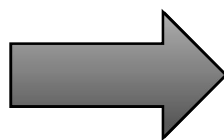


$$I_{c1} = \alpha_1 I_A + I_{CBO1}$$

$$I_{c2} = \alpha_2 I_K + I_{CBO2}$$

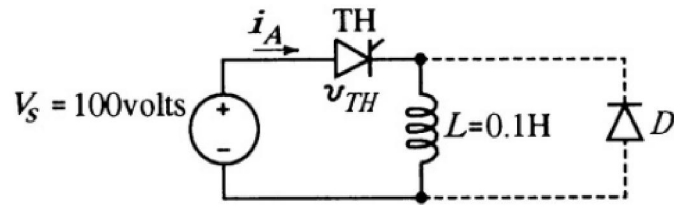
$$I_K = I_A + I_G$$

$$I_A = I_{c1} + I_{c2}$$



$$I_A = \frac{\alpha_2 I_G + I_{CBO1} + I_{CBO2}}{1 - (\alpha_1 + \alpha_2)}$$

مثال: یک سیمپیچ هدایت بالا (بدون مقاومت) توسط یک منبع ایده‌آل و یک تریستور به عنوان کنترلر، شارژ می‌شود. دیود  $D$  یک دیود هرزگرد <sup>۱۶</sup> است. اگر جریان راه‌اندازی <sup>۱۷</sup> تریستور ۴ میلی‌آمپر باشد، مدت زمانی را که پالس گیت باید اعمال شود تا از روشن شدن تریستور اطمینان حاصل شود، محاسبه کنید [۱].

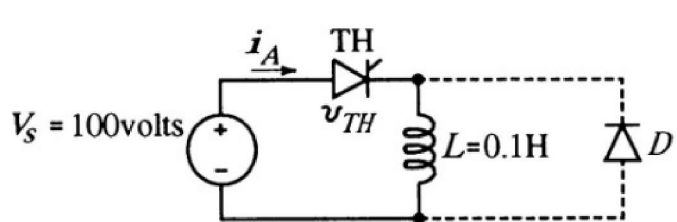


شکل ۴.۱: مثال

<sup>16</sup>Freewheeling

<sup>17</sup>Latching Current

راه‌حل: با توجه به اطلاعات محدود مسئله، باید ترایستور را ایده‌آل فرض کنیم. یعنی، با اعمال پالس گیت ترایستور بدون تاخیر روشن می‌شود و امپدانس آن را صفر در نظر بگیریم. طول پالس گیت باید به اندازه‌ای باشد که جریان اصلی را از صفر به ۴ میلی‌آمپر برساند. پالس گیت در  $t = 0$  آغاز می‌شود. از قانون ولتاژ کیرشهف داریم:



$$V_s = v_{th} + L \frac{di_A}{dt}$$

اما  $v_{th} = V_{th(on)} = 0$  بنابراین با انتگرال‌گیری داریم:

$$i_A = \left(\frac{V_s}{L}\right)t + C$$

که  $C$  یک ثابت است. در  $t = 0$ ،  $i_A = 0$  بنابراین  $C = 0$ . پس،  $i_A = \left(\frac{V_s}{L}\right)t$  بنابراین برای

$$t = \frac{4 \times 10^{-3} \times 0.1}{100} = 4 \mu s, i_A = 4 mA$$

## انواع تریستور

۱. تریستورهای کنترل فاز ( SCR )

۲. تریستورهای کلیدزنی سریع

۳. تریستورهای خاموش شونده با گیت ( GTO )

۴. تریستورهای سه قطبی دو جهته ( TRIAC )

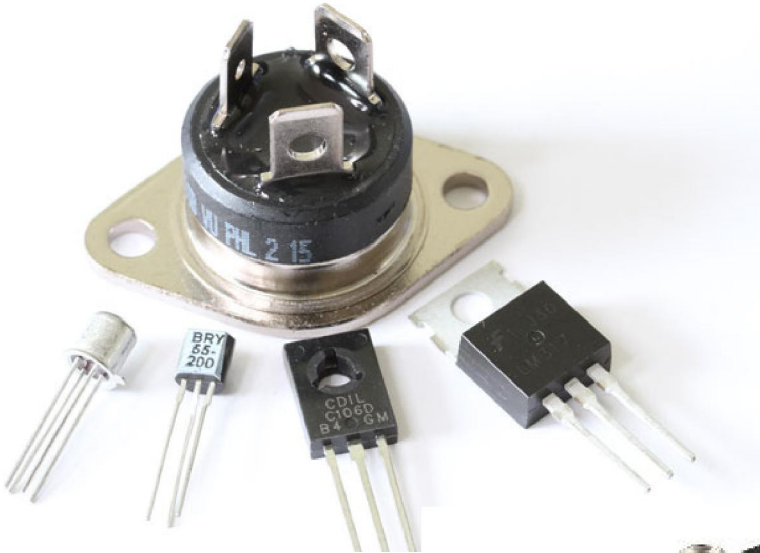
۵. تریستورهای هدایت معکوس ( RCT )

۶. تریستورهای القای استاتیک ( SITH )

۷. یکسوکننده‌های کنترل شده سیلیکونی فعال شونده با نور ( LASCR )

۸. تریستورهای کنترل شده از نوع FET ( FET-CTH )

۹. تریستورهای کنترل شده از نوع MOS ( MCT )



swagatam innovations

Cathode  
Anode  
Gate